

Изобретение относится к области фотоники, а именно к установкам для регистрации фотонов, в частности к фоточувствительным элементам фотодетекторов на основе полупроводников.

Фоточувствительный элемент фотодетектора содержит подложку из стекла (1), на которую нанесены контактный слой (2), фоточувствительный полупроводниковый слой (3) из триселенида мышьяка (As_2Se_3) легированный оловом (Sn) с концентрацией в пределах 3,0...5,0% ат., и второй контактный слой (4).

Результат состоит в том, что фоточувствительный элемент разрешает более точную регистрацию фотонов, обладает высокой фотоэлектрической чувствительностью и вместительной фотоэлектрической памятью.

П. формулы: 1

Фиг.: 2

